

三星開始量產業界位元密度最高的第八代垂直 V-NAND

三星第八代 V-NAND 儲存容量與位元密度雙雙領先業界

助力新世代伺服器進一步擴展儲存空間

全球先進記憶體技術領導品牌三星電子宣佈，已開始量產業界密度居冠的 1Tb TLC (Triple Level Cell) 第八代垂直 NAND (V-NAND)，兌現在 2022 年快閃記憶體高峰會 (Flash Memory Summit) 與 Samsung Memory Tech Day 2022 許下的承諾。新型 V-NAND 亦具備史上最高的儲存容量 1Tb，有望為全球的新世代企業伺服器系統，提供更大的儲存空間。

三星快閃記憶體產品與技術執行副總裁 SungHoi Hur 表示：「隨著市場於更高密度、更大容量記憶體的需​​求升溫，帶動 V-NAND 朝更高層數發展。三星運用先進的 3D 微縮技術壓縮表面積與高度，避免微縮過程常見的單元相互干擾。第八代 V-NAND 有助於滿足快速成長的市場需求，率先推出更多的差異化產品和解決方案，為未來記憶體的創新發展，奠定穩固根基。」

三星藉由大幅提升每片晶圓的位元產出量，達到業界最高的位元密度；第八代 V-NAND 採用最新的 NAND 快閃記憶體標準 Toggle DDR 5.0 介面*，最大輸入 / 輸出 (I/O) 速度每秒可達 2.4Gb，較上一代提升 1.2 倍，預期可滿足 PCIe 4.0 及下一代 PCIe 5.0 的效能需求。

第八代 V-NAND 有望為記憶體配置奠定基石，助力擴展新世代企業伺服器的儲存容量，同時將觸角延伸，應用至對於可靠性要求特別嚴謹的汽車市場。

*編輯附註：Toggle DDR 介面世代演進 - 1.0 (133Mbps)、2.0 (400Mbps)、3.0 (800Mbps)、4.0 (1,200Mbps)、5.0 (2,400Mbps)。